

IMD3

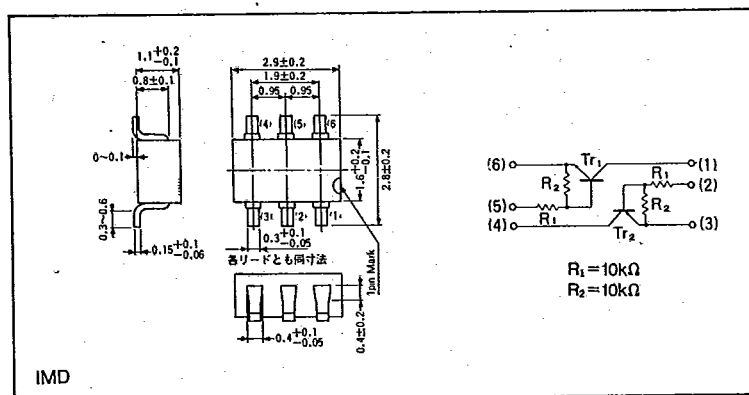
● 特長

- 1) SMT (SC-59) と同一体積に 2 個のトランジスタが入っている。
- 2) SMTの自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

● Features

- 1) Two transistors are housed in the same volume as SMT (SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of SMT can be used for mounting.
- 3) No mutual interference exists between each transistor.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol *	Limits		Unit
		Tr ₁ (NPN)	Tr ₂ (PNP)	
電源電圧	V _{CC}	50	−50	V
入力電圧	V _{IN}	40	−40	V
		−10	10	V
出力電流	I _C	100	−100	mA
	I _O	50	−50	mA
許容損失	P _d	300 (TOTAL)*		mW
保存温度範囲	T _{stg}	−55~125		°C

* ただし、1素子当り200mWをこえないこと。/However, 200mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	$V_{I(OFF)}$	—	—	0.5	V	$V_{CC}=5V, I_O=100\mu A$
	$V_{I(ON)}$	3.0	—	—	V	$V_O=0.3V, I_O=10mA$
出力電圧	$V_{O(ON)}$	—	0.1	0.3	V	$I_O=10mA, I_I=0.5mA$
入力電流	I_I	—	—	0.88	mA	$V_I=5V$
出力電流	$I_{O(OFF)}$	—	—	10	μA	$V_{CC}=30V, V_I=0V$
直流電流増幅率	G_I	30	—	—	—	$I_O=5mA, V_O=5V$
入力抵抗	R_1	—	10	—	k Ω	—
抵抗比率	R_2/R_1	0.8	1.0	1.2	—	—

注(1) 各特性は個々のデジタルトランジスタ(DTr₁, DTr₂)に対する規格です。

注(2) Tr₂PNPトランジスタの一符号は省略しております。

Note(1) Each characteristic relates to the standard for individual digital transistors (DTr₁, DTr₂).

(2) A minus sign for Tr_2 PNP transistor is omitted.

T-43-90

● 標準品・準標準品一覧表

(○: 準標準品)

Type	包装名	テーピング	
	記号	T108	T109
	基本発注単位 (個)	3 000	3 000
IMD3		○	○

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

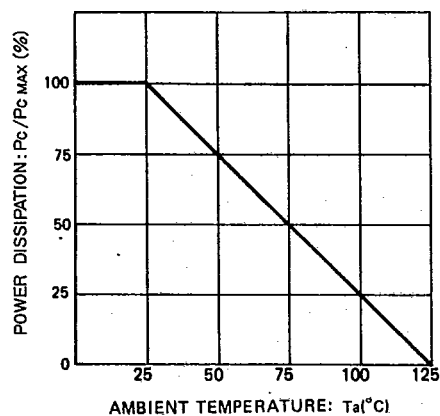
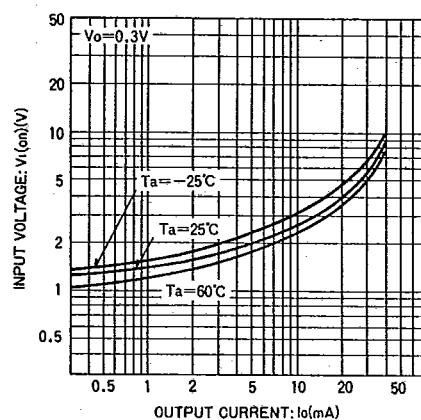
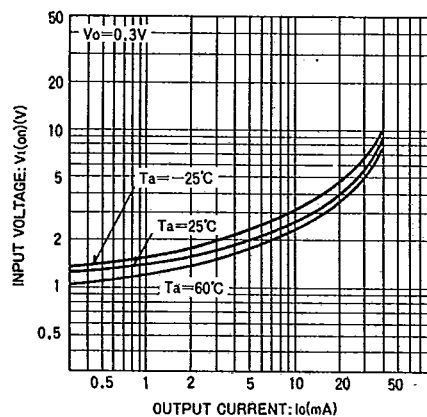
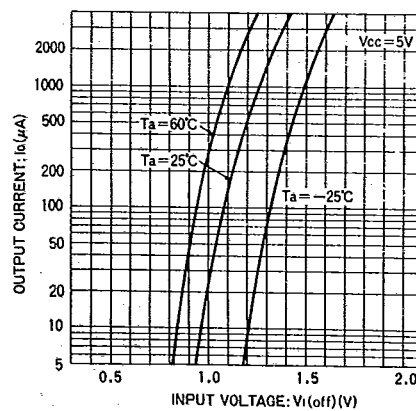
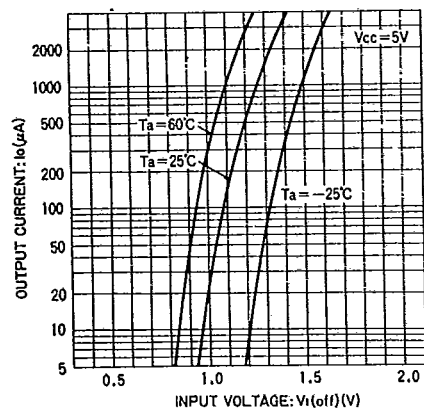
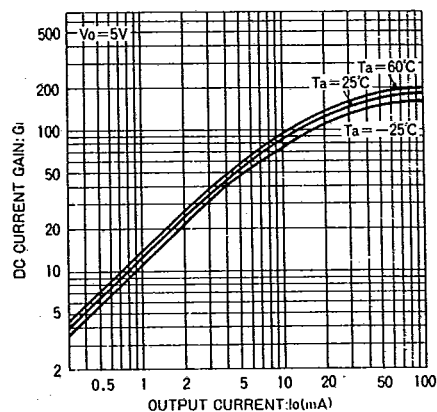
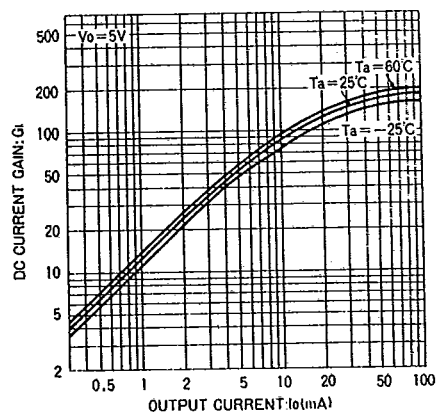


Fig.1 電力軽減曲線

Fig.2 入力電圧—出力電流 (ON特性) (Tr_1)Fig.3 入力電圧—出力電流 (ON特性) (Tr_2)Fig.4 出力電流—入力電圧 (OFF特性) (Tr_1)トランジスタ
IMDタイプ

T-43-90

Fig.5 出力電流—入力電圧 (OFF特性) (Tr_2)Fig.6 直流電流増幅率—出力電流特性 (Tr_1)Fig.7 直流電流増幅率—出力電流特性 (Tr_2)